

А. А. ПАНКОВ

**ОПУСЫ И БАНАХОВЫ РАССЛОЕНИЯ**

(Представлено академиком А. Н. Колмогоровым 24 VII 1974)

Пусть  $X$  — некоторое топологическое пространство (в дальнейшем все топологические пространства предполагаются хаусдорфовыми). Банаховым расслоением над  $X$  будем называть локально-тривиальное расслоенное пространство  $\mathcal{E} \rightarrow X$ , слоем которого служит банахово пространство  $E$  над  $\mathbf{R}$  или  $\mathbf{C}$ , а структурной группой — группа  $GL(E)$  автоморфизмов  $E$ , причем функции перехода <sup>(1)</sup>

$$g_{UV}: (U \cap V) \times E \rightarrow (U \cap V) \times E$$

имеют вид

$$g_{UV}: (x, s) \mapsto (x, \tilde{g}_{UV}(x)s),$$

где  $\tilde{g}_{UV}: U \cap V \rightarrow GL(E)$  — непрерывное отображение. (Группа  $GL(E)$  снабжена равномерной операторной топологией.)

Отображением банахова расслоения  $\mathcal{E}_1$  в банахово расслоение  $\mathcal{E}_2$  (с одной и той же базой  $X$ ) будем называть послойно линейное отображение  $f: \mathcal{E}_1 \rightarrow \mathcal{E}_2$ , которое в локальных картах задается непрерывной функцией со значениями в  $L(E_1, E_2)$ . ( $E_1$  и  $E_2$  — слои  $\mathcal{E}_1$  и  $\mathcal{E}_2$  соответственно,  $L(E_1, E_2)$  — банахово пространство всех линейных непрерывных операторов, действующих из  $E_1$  в  $E_2$ .) Такое отображение будем называть послойно расщепляющим, если для любого  $x \in X$  индуцированное отображение слоев  $f_x: \mathcal{E}_{1x} \rightarrow \mathcal{E}_{2x}$  является расщепляющим. (Это означает, что образ  $\text{im } f_x$  — замкнутое и дополняемое подпространство в  $\mathcal{E}_{2x}$ , а ядро  $\text{ker } f_x$  — дополняемое подпространство в  $\mathcal{E}_{1x}$ .)

Пусть  $E$  — банахово пространство. Обозначим  $m(E)$  банахово пространство всех последовательностей  $\xi = \{\xi_i\}_{i=1}^{\infty}$ ,  $\xi_i \in E$ , для которых конечна норма

$$\|\xi\|_m = \sup_{1 \leq i < \infty} \|\xi_i\|.$$

Если  $\mathcal{E}$  — банахово расслоение с компактной базой  $X$ , то имеет место изоморфизм расслоений <sup>(2)</sup>

$$\mathcal{E} \oplus m(E) \simeq m(E).$$

Для краткости через  $E$  мы обозначаем также тривиальное расслоение со слоем  $E$ ; в нашем случае  $E$  — слой  $\mathcal{E}$ .

Рассмотрим теперь категорию  $\mathcal{B}$ , объектами которой являются банаховы расслоения с компактными базами (для объектов категории  $\mathcal{B}$  будем использовать обозначения вида  $(X, \mathcal{E})$ ). Морфизмами этой категории служат пары  $f = (\varphi, \psi): (X, \mathcal{E}) \rightarrow (Y, \mathcal{F})$ , где  $X \rightarrow Y$  — непрерывное отображение баз, а  $\psi: \varphi^* \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E}$  — отображение банаховых расслоений с общей базой ( $\varphi^* \mathcal{F}$  — обратный образ расслоения  $\mathcal{F}$  при отображении  $\varphi$ ). Композиция морфизмов определяется равенством

$$(\varphi_1, \psi_1) \circ (\varphi_2, \psi_2) = (\varphi_1 \circ \varphi_2, \psi_2 \circ \varphi_2^*(\psi_1)).$$

Любой морфизм категории  $\mathcal{B}$  представим в виде  $(\varphi, \psi) = \bar{\varphi} \circ \psi$ , где  $\bar{\varphi} = (\varphi, \text{id})$ ,  $\psi = (\text{id}, \psi)$ .

Поставим в соответствие каждому объекту  $(X, \mathcal{E})$  банахово пространство  $\Gamma(\mathcal{E})$  сечений расслоения  $\mathcal{E}$ . Это соответствие определяет контравари-

риантный функтор из категории  $\mathcal{B}$  в категорию банаховых пространств. В соответствии с дополнением 1 к книге <sup>(3)</sup> дадим

**Определение.** Пусть  $f: (X, \mathcal{E}) \rightarrow (Y, \mathcal{F})$  — морфизм категории  $\mathcal{B}$ . Непрерывный линейный оператор  $u: \Gamma(\mathcal{E}) \rightarrow \Gamma(\mathcal{F})$  называется линейным опусом для  $f$ , если

$$\Gamma(f) \circ u \circ \Gamma(f) = \Gamma(f).$$

Оператор  $u$  будем называть линейным оператором продолжения (осреднения), если

$$\Gamma(f) \circ u = \text{id}_{\Gamma(\mathcal{E})} \quad (u \circ \Gamma(f) = \text{id}_{\Gamma(\mathcal{F})}).$$

**Замечание.** Опусы, рассмотренные в <sup>(3)</sup>, включаются в нашу схему. Это опусы для морфизмов вида  $\bar{\varphi}$  тривиальных одномерных расслоений.

1. **Случай постоянной базы.** Пусть задан морфизм

$$\underline{\psi} = (\text{id}, \psi): (X, \mathcal{E}) \rightarrow (X, \mathcal{F}).$$

Для каждого  $x \in X$  положим (ср. <sup>(4)</sup>)

$$k(\psi_x) = \sup_{\xi \in \text{Im } \psi_x, \|\xi\|=1} \inf_{\psi_x \xi = \xi} \|\xi\|.$$

Мы считаем здесь, что нормы в слоях расслоений  $\mathcal{E}$  и  $\mathcal{F}$  выбраны непрерывно зависящими от  $x \in X$ . Это всегда можно сделать с помощью разбиения единицы. Положим

$$k(\psi) = \sup_{x \in X} k(\psi_x).$$

Имеет место

**Теорема 1.** Пусть  $\psi: \mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E}$  — послойно расщепляющее отображение. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

- 1)  $\underline{\psi}$  допускает линейный опус;
- 2)  $k(\psi) < \infty$ .

В случае, когда расслоения  $\mathcal{E}$  и  $\mathcal{F}$  тривиальны, утверждение теоремы 1 является простой переформулировкой основного результата <sup>(5)</sup>. В общем случае из изоморфизма (1) следуют изоморфизмы

$$\mathcal{E} \oplus m(E \oplus F) \simeq m(E \oplus F) \simeq \mathcal{F} \oplus m(E \oplus F), \quad (2)$$

где  $E$  и  $F$  — слои расслоений  $\mathcal{E}$  и  $\mathcal{F}$  соответственно. Изоморфизмы (2) позволяют свести доказательство к случаю тривиальных расслоений.

2. **Замена базы.** Рассмотрим теперь морфизмы вида

$$\bar{\varphi} = (\varphi, \text{id}): (X, \varphi^* \mathcal{E}) \rightarrow (Y, \mathcal{E}).$$

В этом случае имеет место следующая теорема, обобщающая предложение 2.8 <sup>(3)</sup>.

**Теорема 2.** Следующие утверждения эквивалентны:

- 1) отображение  $\varphi: X \rightarrow Y$  допускает линейный опус (соответственно оператор продолжения, осреднения);
- 2) для некоторого  $\mathcal{E}$  морфизм вида  $\bar{\varphi} = (\varphi, \text{id})$  допускает линейный опус (соответственно оператор продолжения, осреднения);
- 3) для любого  $\mathcal{E}$  морфизм вида  $\bar{\varphi} = (\varphi, \text{id})$  допускает линейный опус (соответственно оператор продолжения, осреднения).

Доказательство импликации 1)  $\Rightarrow$  3) основано на предложении 2.8 работы <sup>(3)</sup> и изоморфизма (1). Импликация 3)  $\Rightarrow$  2) очевидна. Доказательство последней импликации 2)  $\Rightarrow$  1) использует тот факт <sup>(6)</sup>, что в любом бесконечномерном банаховом расслоении с компактной базой существует тривиальное одномерное подрасслоение.

3. Из теорем 1, 2 и представления  $(\varphi, \psi) = \bar{\varphi} \circ \psi$  вытекают следующие утверждения.

**Предложение 1.** Пусть  $\varphi: \varphi^*\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E}$  — послойно расщепляющий морфизм. Если  $\varphi: X \rightarrow Y$  допускает линейный опус (оператор осреднения), то морфизм  $(\varphi, \psi)$  допускает линейный опус (оператор осреднения).

**Предложение 2.** Пусть  $\varphi: X \rightarrow Y$  допускает линейный оператор продолжения. Если  $\psi: \varphi^*\mathcal{F} \rightarrow \mathcal{E}$  — послойно расщепляющее отображение и  $k(\psi) < \infty$ , то морфизм  $(\varphi, \psi)$  допускает линейный опус. Если при этом  $\psi$  — эпиморфизм, то  $(\varphi, \psi)$  допускает линейный оператор продолжения.

**Замечание.** Если  $\psi$  — эпиморфизм, то автоматически  $k(\psi) < \infty$  (см. (4)).

4. Пусть  $Z \rightarrow Y$  — локально-тривиальное компактное расслоенное пространство со слоем  $T$ . Группа  $\text{Aut}(T)$  гомеоморфизмов  $T$  действует на пространстве  $C(T)$  непрерывных функций левыми сдвигами:  $(g \circ f)(t) = f(g^{-1}t)$ . Таким образом, с расслоением  $Z \rightarrow Y$  естественным образом ассоциируется банахово расслоение  $\mathcal{F} \rightarrow Y$  со слоем  $C(T)$ . Функциями перехода этого расслоения служат функции перехода  $g_{ij}$  расслоения  $Z \rightarrow Y$ . Заметим, что  $\Gamma(\mathcal{F})$  канонически изоморфно пространству  $C(Z)$ .

Пусть теперь задано отображение компактных расслоенных пространств

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{\sigma} & Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{\varphi} & Y \end{array}$$

Обозначим через  $\mathcal{E}$  банахово расслоение со слоем  $C(S)$  ( $S$  — слой  $W$ ), ассоциированное с расслоением  $W$ . Отображение  $(\varphi, \sigma)$  индуцирует морфизм  $(\varphi, \sigma^0): (X, \mathcal{E}) \rightarrow (Y, \mathcal{F})$  категории  $\mathcal{B}$ . \* При этом морфизм  $(\varphi, \sigma^0)$  допускает опус тогда и только тогда, когда  $\sigma$  допускает опус (в смысле (3)).

Теперь предложения 1 и 2 дают следующее утверждение.

**Теорема 3.** 1) Пусть  $\varphi: X \rightarrow Y$  допускает линейный опус (оператор осреднения) и пусть для любого  $x \in X$  отображение  $\sigma_x: W_x \rightarrow Z_{\varphi(x)}$  допускает линейный оператор осреднения. Тогда  $\sigma: W \rightarrow Z$  допускает линейный опус (оператор осреднения).

2) Пусть  $\varphi$  допускает линейный оператор продолжения,  $\sigma_x$  допускает линейный опус для всех  $x \in X$  и  $k(\sigma^0) < \infty$ . Тогда  $\sigma$  допускает линейный опус. Если же для всех  $x \in X$  отображение  $\sigma_x$  допускает линейный оператор продолжения, то и  $\sigma$  допускает линейный оператор продолжения.

5. В качестве еще одного приложения результатов п. 2 обсудим вопрос о принадлежности пространства  $C(Z)$  ( $Z$  — компактное расслоенное пространство с базой  $Y$  и слоем  $T$ ) к классам  $\mathcal{P}_\lambda$ . \*\*

Обозначим через  $\mathcal{F}$  банахово расслоение с базой  $Y$  и слоем  $C(T)$ , ассоциированное с расслоением  $Z$  (см. п. 3). Имеет место изоморфизм  $\Gamma(\mathcal{F}) \simeq C(Z)$ . Более того, нетрудно показать, что этот изоморфизм является изометрическим при естественном выборе нормы в  $\Gamma(\mathcal{F})$ . Пусть  $\varphi_Y: C_Y \rightarrow Y$  — эпиморфизм Глисона (см. (7)), т. е. неприводимый эпиморфизм экстремально несвязного (8) компакта  $G_Y$  на  $Y$ . Тогда существуют такие тривиальное банахово расслоение  $\mathcal{E}_Z = G_Y \times C(S)$ , где  $S$  экстремально несвязно, и морфизм  $f_Z: (G_Y, \mathcal{E}_Z) \rightarrow (Y, \mathcal{F})$  категории  $\mathcal{B}$  вида  $f_Z = (\varphi_Y, \psi)$ , что  $\Gamma(f_Z): \Gamma(\mathcal{E}_Z) \rightarrow \Gamma(\mathcal{F})$  — изометрический мономорфизм и  $\Gamma(\mathcal{F}) = C(Z)$  принадлежит классу  $\mathcal{P}_\lambda$  тогда и только тогда, когда  $f_Z$  допускает линейный оператор осреднения нормы  $\leq \lambda$ . (Роль морфизма  $f_Z$  аналогична роли эпиморфизма Глисона (3). Конструкцию морфизма  $f_Z$  мы опускаем. Отметим только, что она основана на стабильной тривиальности банаховых расслоений. На самом деле пространство  $S$  имеет вид  $G_T \times \Delta$ , где  $\Delta$  — конечное множество.)

\*  $\sigma^0$  действует по формуле  $\sigma^0: h(t) \rightarrow h(\sigma_x t)$ , где  $t \in (\varphi^*Z)_x \simeq T$  и  $h \in (\varphi^*\mathcal{F})_x \simeq C(T)$ .

\*\* Напомним (см., например (3)), что банахово пространство  $E$  принадлежит  $\mathcal{P}_\lambda$  ( $\mathcal{P}'_\lambda$ ), если для любого (сепарабельного) банахова пространства  $F$  и для любого изометрического вложения  $u: E \rightarrow F$  существует проектор в  $F$  на  $uE$  нормы  $\leq \lambda$ .

Справедлива следующая

Теорема 4. Если  $C(Y) \in \mathcal{P}_\lambda$  и  $C(T) \in \mathcal{P}_\mu$ , то  $C(Z) \in \mathcal{P}_{\lambda\mu}$ .

Рассмотрим теперь вопрос о принадлежности  $C(Z)$  классам  $\mathcal{P}_\lambda'$ . Пусть  $C(Y) \in \mathcal{P}_\lambda'$  и  $C(T) \in \mathcal{P}_\mu'$ . Имеем изоморфизм  $(^3) C(Y) \simeq C(T) \simeq C$ . Кроме того,  $c \simeq c_0$   $(^{10})$  ( $c(c_0)$  — пространство всех сходящихся (к нулю) последовательностей). Поскольку  $Gl(c_0)$  стягиваема  $(^{11})$ , то расслоение  $\mathcal{F}$  тривиально. Следовательно,  $C(Z) \simeq \Gamma(\mathcal{F}) \simeq c(c)$  ( $c(E)$  — пространство всех сходящихся последовательностей элементов из  $E$ ). Нетрудно заметить, что  $c(c) \simeq c$ . Тогда  $(^9) C(Z) \in \mathcal{P}_\nu'$  для некоторого  $\nu$ .

Белгородский технологический  
институт строительных материалов

Поступило  
10 III 1974

#### ЦИТИРОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- <sup>1</sup> Д. Хьюзмоллер, Расслоенные пространства, М., 1970. <sup>2</sup> П. А. Кучмент, Канд. дисс. Воронеж, 1972. <sup>3</sup> А. Пелчинский, Линейные продолжения, линейные усреднения и их применения, М., 1970. <sup>4</sup> А. С. Маркус, Уч. зап. Кишиневск. гос. унив. т. 39, 265 (1959). <sup>5</sup> Ю. Лайтгер, Матем. исследования, т. 5, 4, Кишинев, 1970, стр. 115. <sup>6</sup> П. А. Кучмент, Тр. н.-и. инст. математики, Воронежск. гос. унив. в. 5, 80 (1972). <sup>7</sup> А. М. Gleason, Illinois J. Math., v. 2, 482 (1958). <sup>8</sup> Дж. Келли, Общая топология, М., 1968. <sup>9</sup> D. Amir, Proc. Am. Math. Soc., v. 15, 396 (1964). <sup>10</sup> S. Banach, Theorie des operations linéaires, Warszawa, 1932. <sup>11</sup> G. Neubauer, Math. Ann., v. 174, 33 (1967).